



特点

- 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
- 全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 真空+氢气保护焊接技术
- 体积小，重量轻

典型应用

- 交直流电极控制,工业加热控制,调光,无触点开关
- 电机软启动,静止无功补偿,电焊机
- 变频器, UPS电源, 电池充放电

$I_{T(AV)}$	90A
V_{DRM}/V_{RRM}	500-2500V
I_{TSM}	2.0 KA
I^2t	20 $10^3 a^2 s$

符号	参数	测试条件	结温 T_J (°C)	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50HZ 双面散热, $T_c=85^\circ C$	125			90	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流		125			141	A
V_{DRM} V_{RRM}	断态重复峰值电压 反向重复峰值电压	$V_{DRM} \& V_{RRM}$ tp=10ms $V_{DSM} \& V_{RSM}=V_{DRM} \& V_{RRM}+200V$	125	500		2500	V
I_{DRM} I_{RRM}	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$ $V_{RM}=V_{RRM}$	125			15	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波 $V_R=0.6V_{RRM}$	125			2.0	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积					20	$A^{2S} * 10^3$
V_{TO}	门槛电压		125			0.8	V
r_T	斜率电阻					3.01	$m\Omega$
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=270A$	25			1.15	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	125			800	V/us
di/dt	通态电流临界上升率	$I_{MT}=52A$ 门极触发电流幅值 $I_{GR}=1.5A$ 门极电流上升时间 $t \leq 0.5\mu s$	125			100	A/us
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	30		100	mA
V_{GT}	门极触发电压			1.0		2.5	V
I_H	维持电流			20		150	mA
V_{GD}	门极不触发电压	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	125	0.2			V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗 (结至壳)	180° 正弦波, 单面散热				0.280	°C/W
$R_{th(c-h)}$	热阻抗 (壳至散)	180° 正弦波, 单面散热				0.2	°C/W
V_{iso}	绝缘电压			2500			V
F_M	安装扭矩 (M5)				4		N·m
	安装扭矩 (M6)				6		N·m
T_{stq}	储存温度			-40		125	°C
W_t	质量						g
Outline	外形						

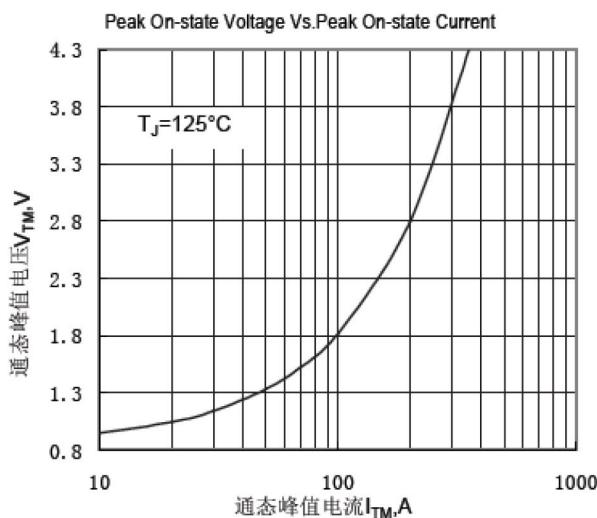


Fig.1 通态伏安特性曲线

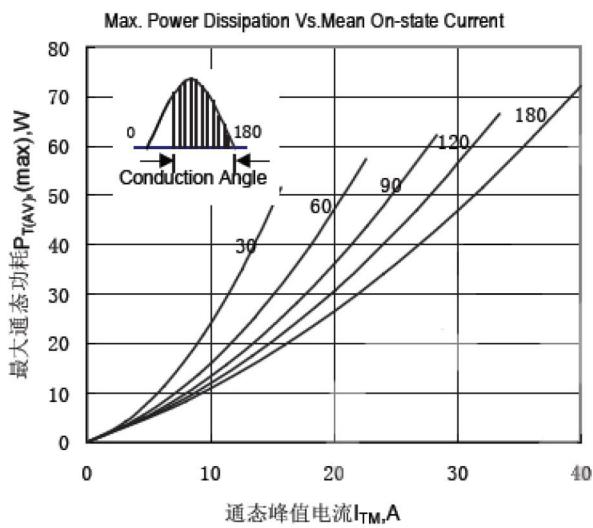


Fig.3 最大功耗与平均电流关系曲线

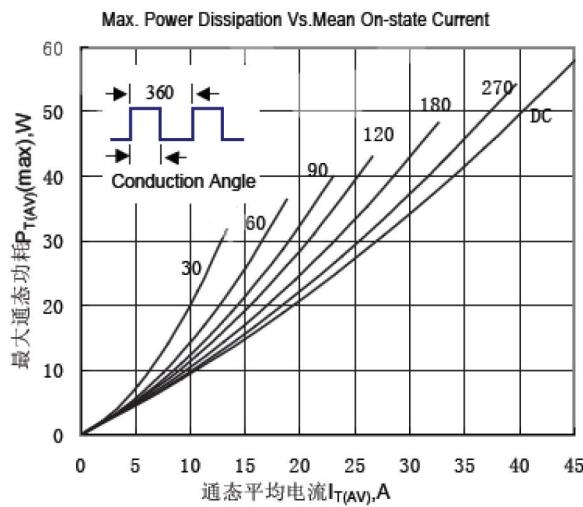


Fig.5 最大功耗与平均电流关系曲线

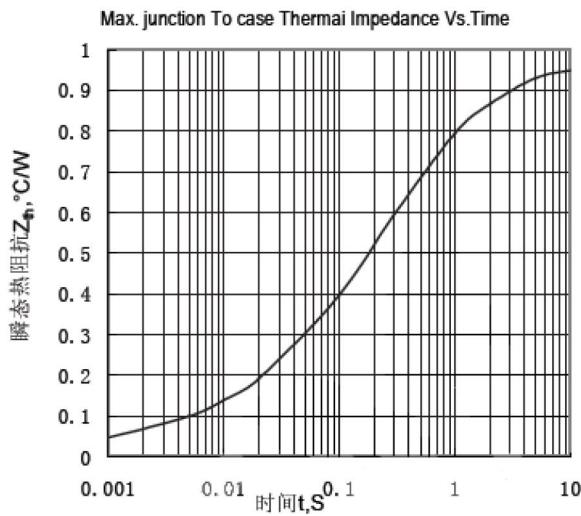


Fig.2 结至管壳瞬态热阻抗曲线

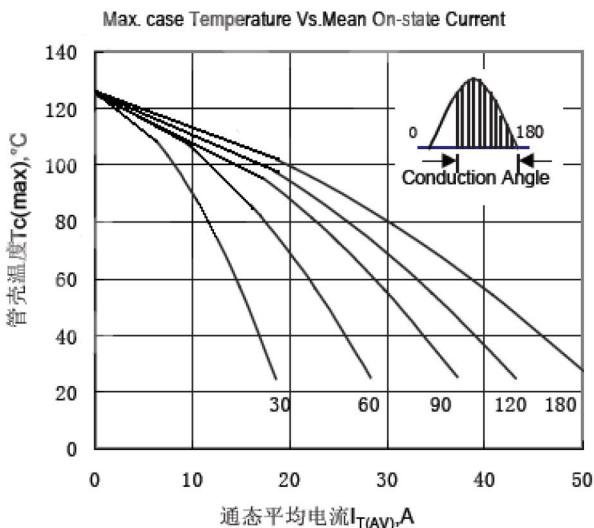


Fig.4 管壳温度与通态平均电流关系曲线

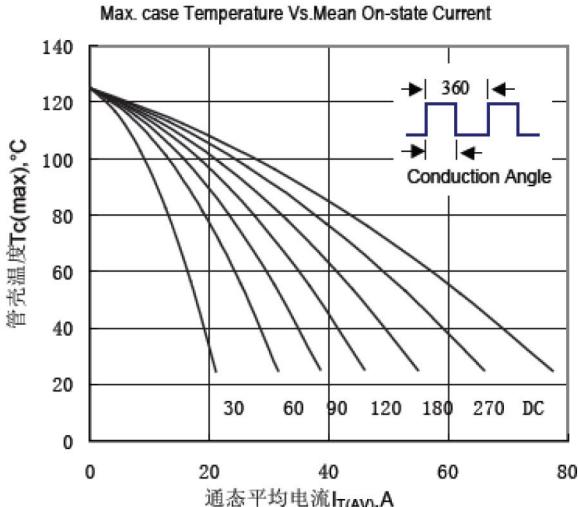


Fig.6 管壳温度与通态平均电流关系曲线



上整整流器
RECTIFIER
SHANGZHENG®

MFC、MFX、MFA、MFK、SKKH、MCD90A 普通/整流混合模块

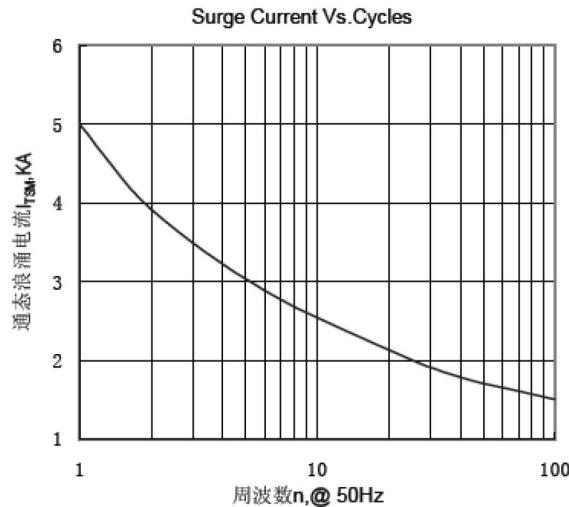


Fig.7 通态浪涌电流与周波数的关系曲线

Gate characteristic at 25°C junction temperature

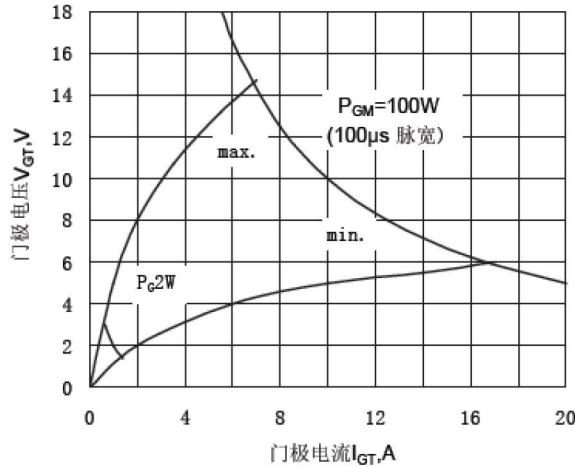


Fig.9 门极功率曲线

外形图： 代号： 201F

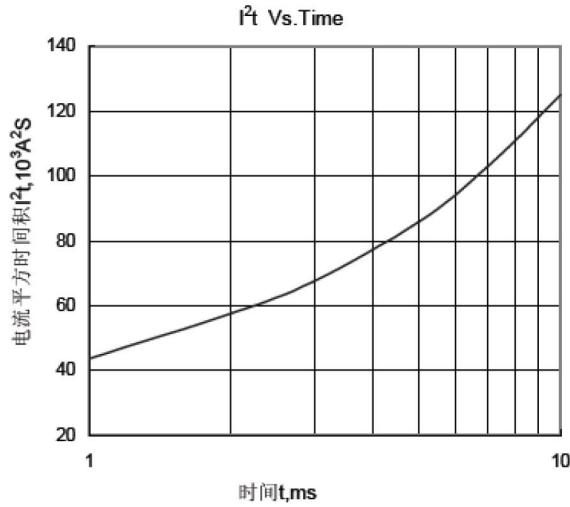


Fig.8 I²t 特性曲线

Gate Trigger Zone at varies temperature

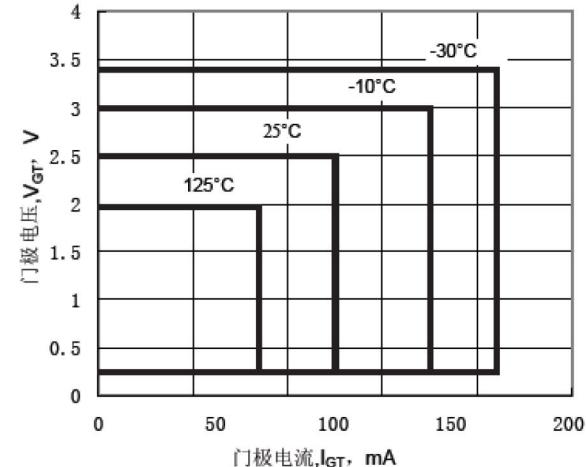
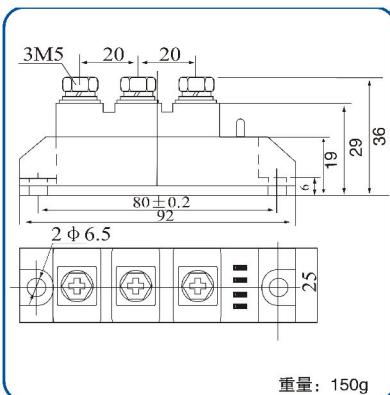
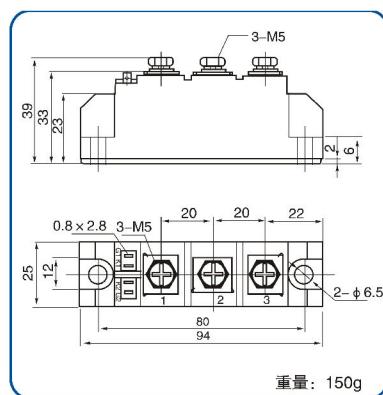


Fig.10 门极触发特性曲线

代号： 201F-1





上整整流器
RECTIFIER
SHANGZHENG®

MFC、MFX、MFA、MFK、SKKH、MCD90A 普通/整流混合模块

线路图：

